



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 35008—2018

---

## 串行 NOR 型快闪存储器接口规范

Specification for serial NOR flash interface

2018-03-15 发布

2018-08-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

# 目 次

前言 .....	I
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 物理接口 .....	1
4.1 引出端功能定义 .....	1
4.2 数据接口类型 .....	2
5 存储阵列架构 .....	3
5.1 存储架构 .....	3
5.2 状态寄存器 .....	3
5.3 器件保护功能 .....	4
5.4 器件自毁功能 .....	4
6 指令定义 .....	5
6.1 指令集说明 .....	5
6.2 指令集描述 .....	7
6.3 指令格式模式 .....	25
7 参数表说明 .....	26
7.1 参数表头定义 .....	26
7.2 参数列表定义 .....	26
附录 A (资料性附录) 块保护描述 .....	29

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本标准由全国半导体器件标准化技术委员会(SAC/TC 78)归口。

本标准起草单位:北京兆易创新科技股份有限公司、工业和信息化部电子工业标准化研究院、中国电子科技集团公司第五十八研究所、清华大学微电子学研究所、深圳市中兴微电子技术有限公司。

本标准主要起草人:刘超、刘会娟、苏志强、高硕、李锴、赵桂林、吴华强、武鹏。

# 串行 NOR 型快闪存储器接口规范

## 1 范围

本标准规定了串行或非(NOR)型快闪存储器(以下称为器件)的物理接口、存储阵列架构、指令定义和参数表说明等。

本标准适用于地址为 24 位的串行 NOR 型快闪存储器的设计和使用。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 17574—1998 半导体器件 集成电路 第 2 部分:数字集成电路

## 3 术语和定义

GB/T 17574—1998 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**状态寄存器 status register**

存储器内部标志内部状态的寄存器。

## 4 物理接口

### 4.1 引出端功能定义

器件引出端功能定义见表 1。

表 1 引出端功能定义

引出端	输入/输出	描述
CS#	输入	片选信号输入,低电平有效
SO/SIO1	输入/输出	串行数据输出端/串行数据端 1
WP#/SIO2	输入/输出	写保护端,低电平有效/串行数据端 2
GND	地	地
SI/SIO0	输入/输出	串行数据输入端/串行数据端 0
SCLK	输入	串行时钟输入端
HOLD#/SIO3	输入/输出	保持功能输入端,低电平有效/串行数据端 3
VCC	电源	供电电源